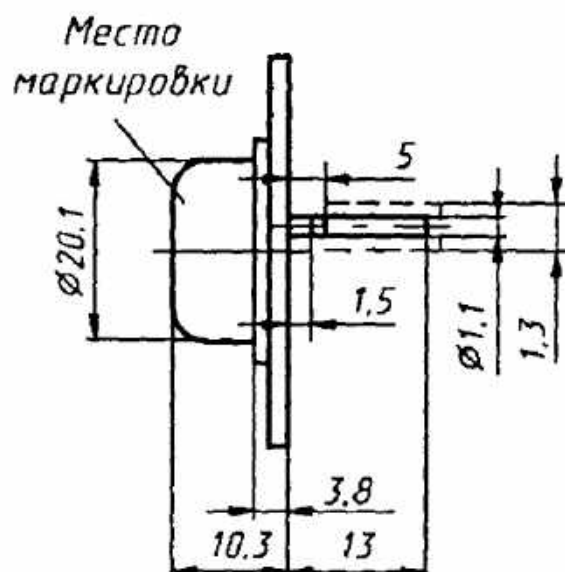
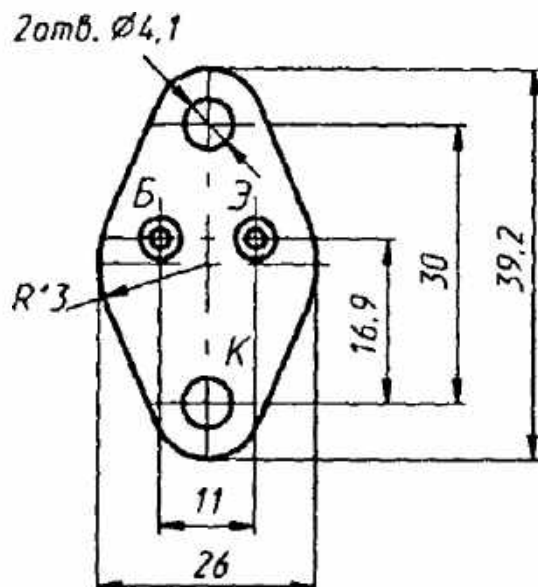


2Т812А, 2Т812Б, КТ812А, КТ812Б, КТ812В

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* импульсные. Предназначены для применения в импульсных и переключательных устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 20 г.

2Т812(А, Б) КТ812(А-В)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

$T_K = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$:

$U_{KЭ} = 3\text{ В}$, $I_K = 8\text{ А}$ для 2Т812А,

2Т812Б 5...15*...30*

$U_{KЭ} = 2,5\text{ В}$, $I_K = 8\text{ А}$ для КТ812А,

КТ812Б, не менее 4

$U_{KЭ} = 5\text{ В}$, $I_K = 5\text{ А}$ для КТ812В 10...80*...125*

$T_K = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_{KЭ} = 3\text{ В}$, $I_K = 5\text{ А}$ для

2Т812А, 2Т812Б, не менее 4

$T_K = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_{KЭ} = 3\text{ В}$, $I_K = 8\text{ А}$ для

2Т812А, 2Т812Б, не менее 3

Модуль коэффициента передачи тока на вы-
сокой частоте при $f = 1\text{ МГц}$, $U_{KЭ} = 10\text{ В}$,

$I_K = 0,2\text{ А}$ 3,5...6,5*...8,4*

Граничное напряжение при $I_K = 0,1$ А, $I_{K, \text{нас}} = 300$ мА, $L = 40$ мГн	350...450*... 650* В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 8$ А, $I_B = 1,6$ А	1*...1,35*... 2,5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 8$ А, $I_B = 1,6$ А	1,8*...2,2*... 2,5 В
Время спада при $U_{KЭ} = 250$ В, $U_{БЭ} = 4$ В, $I_K = 5$ А, $I_B = 2,5$ А	0,22...0,6*... 1,3 мкс
Обратный ток коллектора, не более:	
$T = +25$ °С, $U_{КБ} = 700$ В для 2Т812А, КТ812А, $U_{КБ} = 500$ В для 2Т812Б, КТ812Б, $U_{КБ} = 300$ В для КТ812В	5 мА
типовое значение	0,5* мА
$T = +125$ °С, $U_{КЭ} = 400$ В для 2Т812А, $U_{КБ} = 300$ В для 2Т812Б	10 мА
$T = -60$ °С, $U_{КБ} = 500$ В для 2Т812А, $U_{КБ} = 400$ В для 2Т812Б	10 мА
Обратный ток эмиттера не более:	
$U_{ЭБ} = 6$ В для 2Т812А, 2Т812Б	50 мА
типовое значение	5* мА
$U_{ЭБ} = 7$ В для КТ812А, КТ812Б, КТ812В	150 мА
Емкость коллекторного перехода	
при $U_{КБ} = 100$ В	70*...85*... 100* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $R_{БЭ} = 10$ Ом, $t_H \leq 20$ мкс, $t_\Phi \geq 3$ мкс, $Q \geq 3$, $T_K = -40...85$ °С для 2Т812А, 2Т812Б и $t_H \leq 1$ мс, $Q \geq 10$ или $t_H \leq 50$ мкс, $Q \geq 2$ для КТ812А, КТ812Б, КТ812В:	
2Т812А, КТ812А	700 В
2Т812Б, КТ812Б	500 В
КТ812В	300 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $R_{БЭ} = 10$ Ом, $t_H \leq 50$ мкс, $t_\Phi \geq 0,3$ мкс, $Q \geq 2$, $T = -40...+85$ °С	
	350 В
Постоянное напряжение база—эмиттер:	

2Т812А, 2Т812Б	6 В
КТ812А, КТ812Б, КТ812В	7 В
Постоянный ток коллектора:	
2Т812А, 2Т812Б	10 А
КТ812А, КТ812Б, КТ812В	8 А
Импульсный ток коллектора:	
2Т812А, 2Т812Б:	
$t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 10$	17 А
$t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 2$	12 А

¹ При понижении температуры корпуса от -40 до -60 °С и при повышении от $+85$ до $+100$ °С $U_{кз, и, макс}$ линейно снижается до 500 В для 2Т812А и до 400 В для 2Т812Б; при повышении температуры корпуса от $+100$ до $+125$ °С $U_{кз, и, макс}$ линейно снижается до 400 В для 2Т812А и до 300 В для 2Т812Б.
При $t_{ф} \geq 0,3$ мкс и понижении температуры корпуса от -40 до -60 °С и при повышении температуры от $+85$ до $+125$ °С $U_{кз, и, макс}$ снижается до 300 В.

КТ812А, КТ812Б, КТ812В при $t_{и} \leq 1$ мс, $Q \geq 10$ или $t_{и} \leq 50$ мкс, $Q \geq 2$		12 А
Постоянный ток базы:		
2Т812А, 2Т812Б	4 А	
КТ812А, КТ812Б, КТ812В	3 А	
Импульсный ток базы:		
2Т812А, 2Т812Б:		
$t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 10$	7 А	
$t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 2$	5 А	
КТ812А, КТ812Б, КТ812В при $t_{и} \leq 1$ мс, $Q \geq 10$ или $t_{и} \leq 50$ мкс, $Q \geq 2$		
	4 А	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ 2Т812А, 2Т812Б при $T_k = -60...+50$ °С и КТ812А, КТ812Б, КТ812В при $T_k = -45...+50$ °С		
	50 Вт	
Температура р-п перехода	+150 °С	
Температура окружающей среды:		
2Т812А, 2Т812Б	$-60...T_k =$ $= +125$ °С	
КТ812А, КТ812Б, КТ812В	$-45...T_k =$ $= +85$ °С	

¹ При повышении температуры корпуса выше $+50$ °С $P_{к, макс}$ снижается в соответствии с формулой

$$P_{к, макс} = (T_p - T_k) R_{T(p-k)}, \text{ Вт.}$$

Значение $R_{T(p-k)}$ определяется из области максимальных режимов.

При применении транзисторов в каскадах строчной развертки телевизоров допускается эксплуатация их с коэффициентом загрузки, равным единице по U_k и I_k ; при этом температура корпуса не должна превышать $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 5 мм, температура пайки не выше $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.